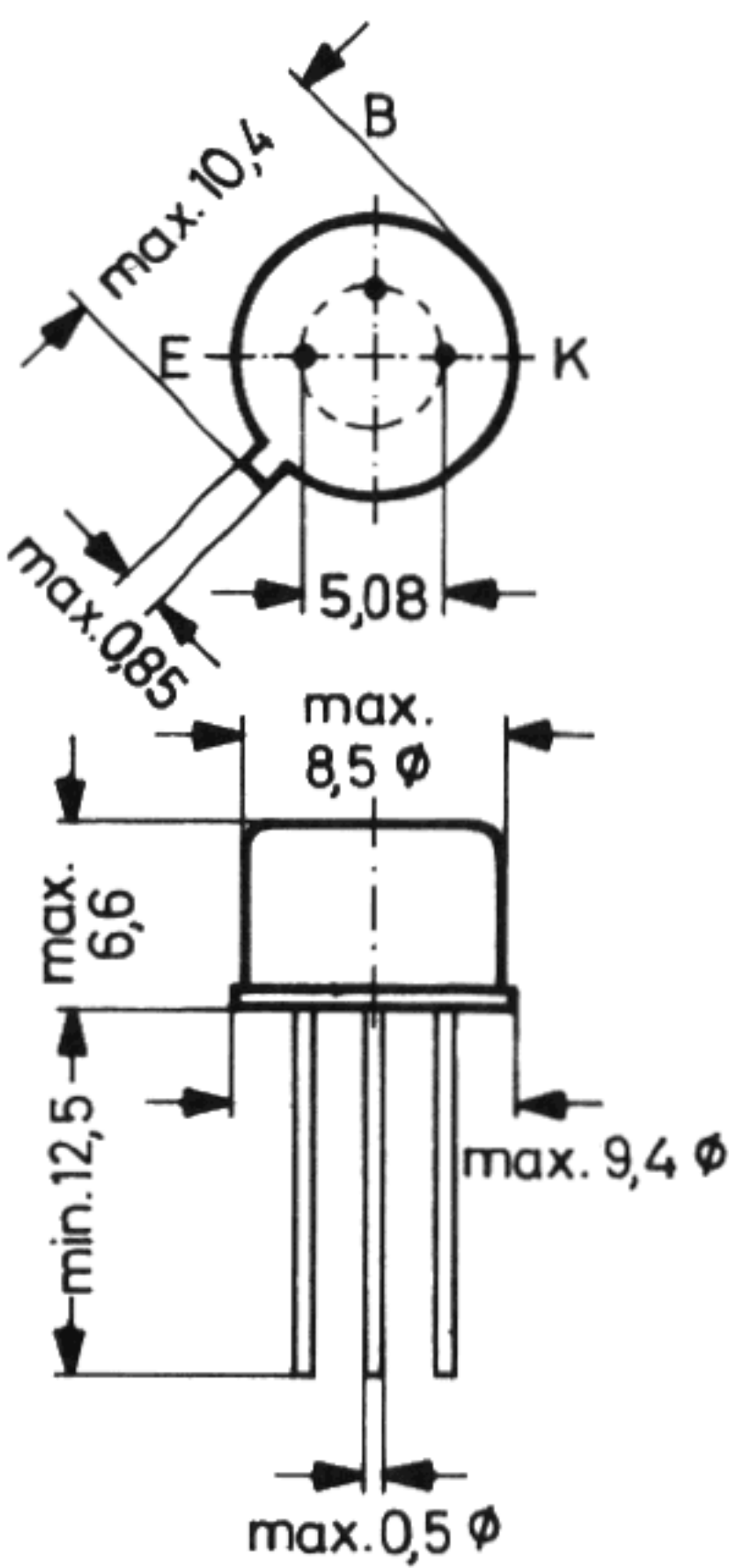


NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistor
für Video-Endstufen

www.datasheetcatalog.com

Metallgehäuse JEDEC TO-39
5 C 3 nach DIN 41 873
Gewicht ca. 1 g
Kollektor mit Gehäuse verbunden
Maße in mm



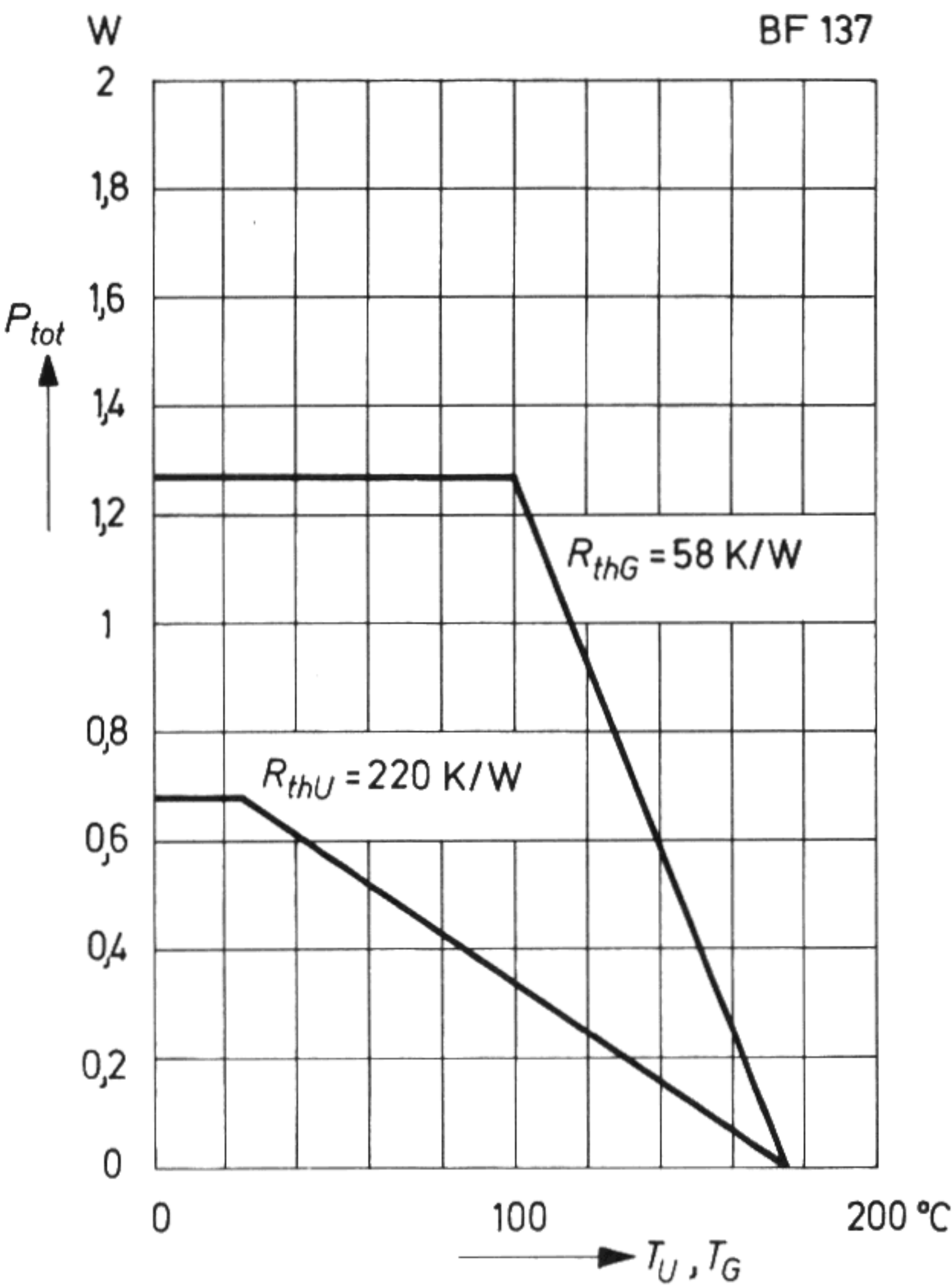
Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	U_{CB0}	160	V
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CE0}	160	V
Emitter-Basis-Spannung	U_{EB0}	5	V
Kollektorstrom	I_C	100	mA
Verlustleistung bei $T_U = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ bei $T_G = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	P_{tot} P_{tot}	680 1,27	mW W
Sperrschichttemperatur	T_i	175	$^{\circ}\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich	T_S	$-55 \dots +175\text{ }^{\circ}\text{C}$	

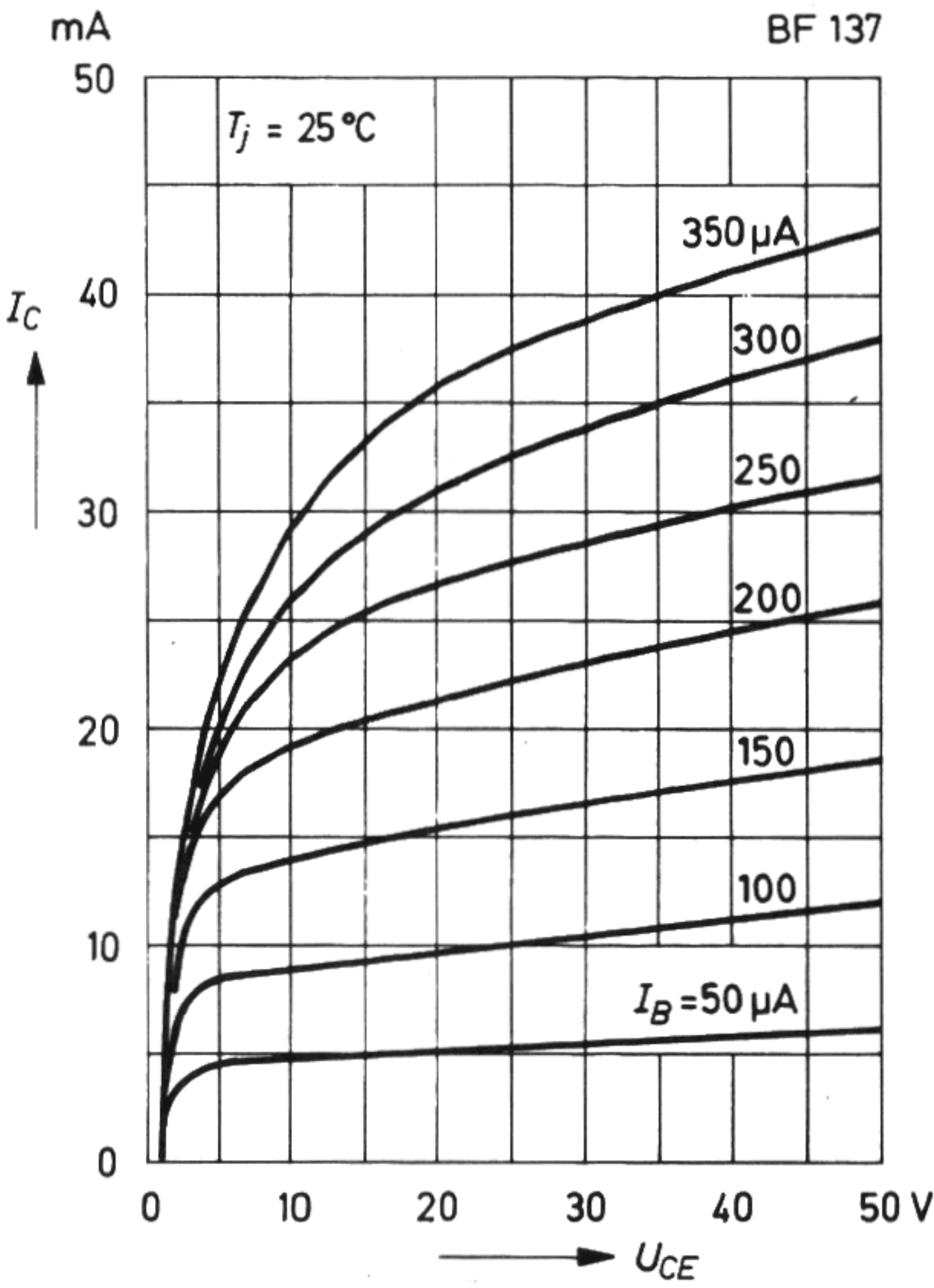
Kennwerte bei $T_i = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Kollektor-Basis-Stromverhältnis bei $U_{CE} = 10\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$	B	> 25	
Kollektor-Sättigungsspannung bei $I_C = 30\text{ mA}$, $I_B = 6\text{ mA}$	U_{CEsat}	< 1	V
Kollektorreststrom bei $U_{CB} = 100\text{ V}$	I_{CB0}	< 10	nA
Emitterreststrom bei $U_{EB} = 4\text{ V}$	I_{EB0}	< 50	nA
Kollektor-Basis-Kapazität bei $U_{CB} = 20\text{ V}$, $f = 500\text{ kHz}$	C_{CB0}	2	pF
Transitfrequenz bei $U_{CE} = 10\text{ V}$, $I_C = 20\text{ mA}$, $f = 50\text{ MHz}$	f_T	95	MHz
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft Sperrschicht – Gehäuse	R_{thU} R_{thG}	< 220 < 58	K/W K/W

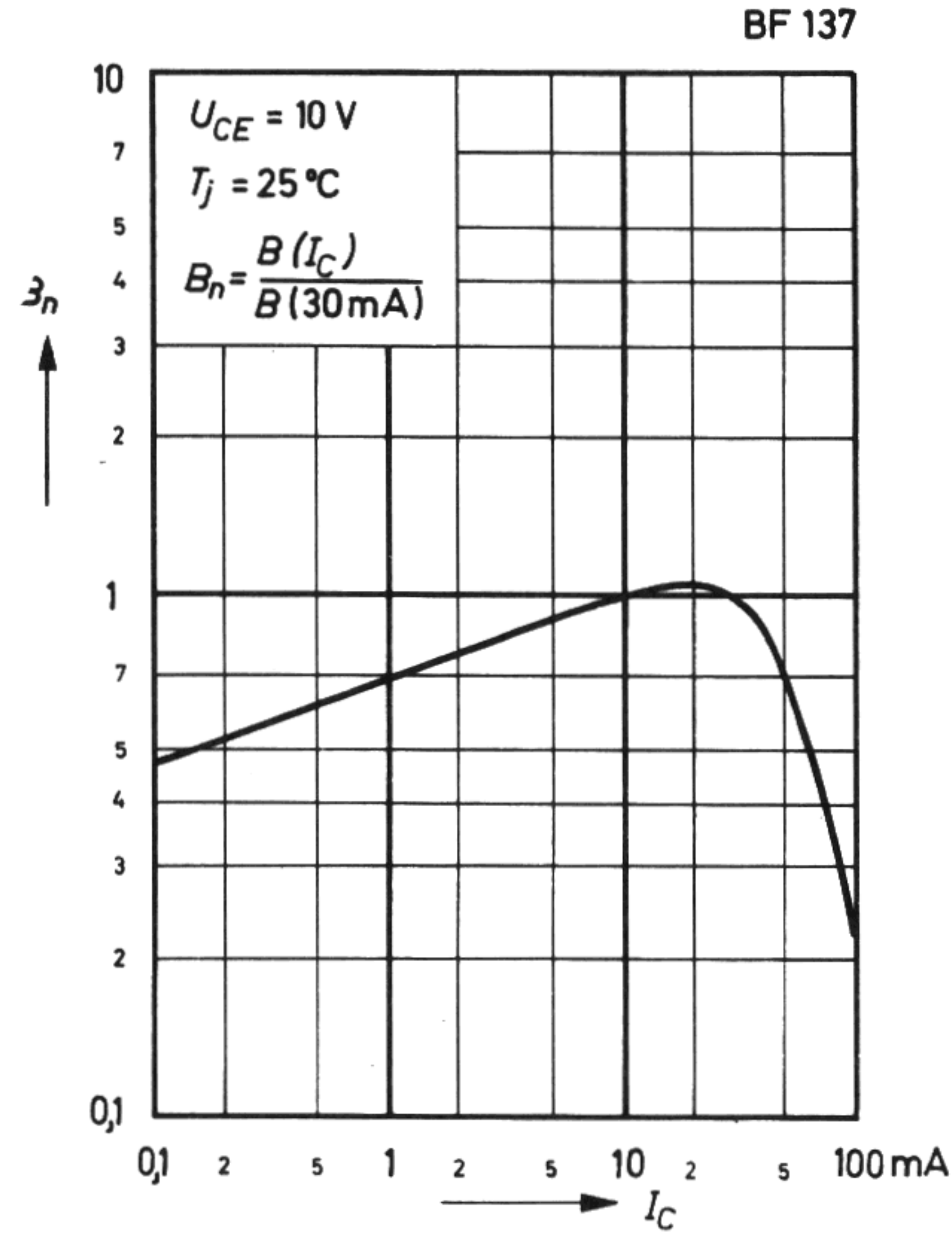
zulässige Gesamtverlustleistung in Abhängigkeit von der Temperatur



Ausgangskennlinien
Emitterschaltung



Kollektor-Basis-Stromverhältnis
in Abhängigkeit
vom Kollektorstrom



Transitfrequenz in Abhängigkeit
vom Kollektorstrom und von der
Kollektor-Emitter-Spannung

